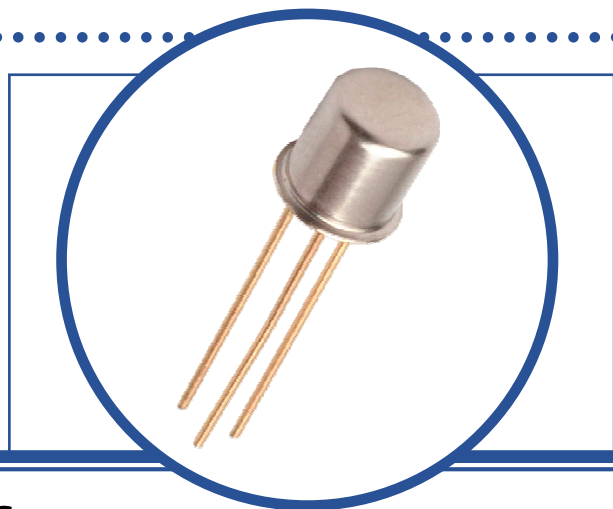


# SILICON PLANAR EPITAXIAL PNP TRANSISTOR

## 2N3799X

- Low Noise
- Hermetic TO-18 Metal package.
- Ideally suited for Low Level Amplifier.  
Instrumentation Amplifiers and General Purpose Applications
- Screening Options Available



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise stated)

V <sub>CBO</sub>	Collector – Base Voltage	-60V
V <sub>CEO</sub>	Collector – Emitter Voltage	-50V
V <sub>EBO</sub>	Emitter – Base Voltage	-5V
I <sub>C</sub>	Continuous Collector Current	-50mA
P <sub>D</sub>	Total Power Dissipation at T <sub>A</sub> = 25°C	360mW
	Derate Above 25°C	2.06mW/°C
P <sub>D</sub>	Total Power Dissipation at T <sub>C</sub> = 25°C	1.2W
	Derate Above 25°C	6.86mW/°C
T <sub>J</sub>	Junction Temperature Range	-65 to +200°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature Range	-65 to +200°C

### THERMAL PROPERTIES

Symbols	Parameters	Min.	Typ.	Max.	Units
R <sub>θJA</sub>	Thermal Resistance, Junction To Ambient			486.11	°C/W
R <sub>θJC</sub>	Thermal Resistance, Junction To Case			145.83	°C/W

Semelab Limited reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.



# SILICON PLANAR EPITAXIAL PNP TRANSISTOR 2N3799X

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

Symbols	Parameters	Test Conditions	Min.	Typ	Max.	Units
$V_{(BR)CEO}^{(1)}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = -10\text{mA}$ $I_B = 0$	-60			V
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage	$I_C = -10\mu\text{A}$ $I_E = 0$	-50			
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-Base Breakdown Voltage	$I_E = -10\mu\text{A}$ $I_C = 0$	-5			
$I_{CBO}$	Collector Cut-Off Current	$V_{CB} = -50\text{V}$ $I_E = 0$			-0.01	$\mu\text{A}$
		$T_A = 150^\circ\text{C}$			-10	
$I_{EBO}$	Emitter Cut-Off Current	$V_{EB} = -4\text{V}$ $I_C = 0$			-20	nA
$V_{CE(sat)}^{(1)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = -100\mu\text{A}$ $I_B = -10\mu\text{A}$			-0.2	V
		$I_C = -1.0\text{mA}$ $I_B = -100\mu\text{A}$			-0.25	
$V_{BE(sat)}^{(1)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = -100\mu\text{A}$ $I_B = -10\mu\text{A}$			-0.7	
		$I_C = -1.0\text{mA}$ $I_B = -100\mu\text{A}$			-0.8	
$V_{BE(on)}$	Base-Emitter On Voltage	$I_C = -100\mu\text{A}$ $V_{CE} = -5\text{V}$			-0.7	
$h_{FE}^{(1)}$	Forward-current transfer ratio	$I_C = -1.0\mu\text{A}$ $V_{CE} = -5\text{V}$	75			
		$I_C = -10\mu\text{A}$ $V_{CE} = -5\text{V}$	225			
		$I_C = -100\mu\text{A}$ $V_{CE} = -5\text{V}$	300			
		$T_A = -55^\circ\text{C}$	150			
		$I_C = -500\mu\text{A}$ $V_{CE} = -5\text{V}$	300			
		$I_C = -1.0\text{mA}$ $V_{CE} = -5\text{V}$	300			
		$I_C = -10\text{mA}$ $V_{CE} = -5\text{V}$	250			

### Notes

(1) Pulse Width  $\leq 300\mu\text{s}$ ,  $\delta \leq 2\%$

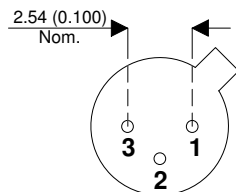
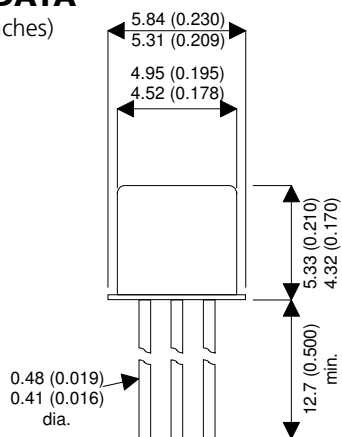
# SILICON PLANAR EPITAXIAL PNP TRANSISTOR 2N3799X

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

$f_T$	Transition Frequency	$I_C = -500\mu A$ $V_{CE} = -5V$	30			MHz	
		$f = 20MHz$					
$C_{obo}$	Output Capacitance	$V_{CB} = -5V$ $I_E = 0$			4	pF	
		$f = 1.0MHz$					
$C_{ibo}$	Input Capacitance	$V_{EB} = -0.5V$ $I_C = 0$			8		
		$f = 1.0MHz$					
$h_{ie}$	Input Impedance	$I_C = -1.0mA$ $V_{CE} = -10V$ $f = 1.0MHz$	10		40	K $\Omega$	
$h_{oe}$	Output Admittance		5		60	$\mu hmos$	
$h_{re}$	Voltage Feedback Ratio				25	$\times 10^{-4}$	
$h_{fe}$	Small Signal Current Gain		300		900		
$N_F$	Noise Figure	$V_{CE} = -10V$ $I_C = -100\mu A$ $R_G = 3K\Omega$		$f=100Hz$ $BW=20Hz$	2.5	4	dB
			<b>Spot:</b>	$f=1.0KHz$ $BW=200Hz$	0.8	1.5	
			<b>Noise:</b>	$f=10KHz$ $BW=2KHz$	1.8	1.5	
				$f=1.0KHz$	1.5	2.5	

## MECHANICAL DATA

Dimensions in mm (inches)



## TO-18 (TO-206AA) METAL PACKAGE Underside View

Pin 1 - Emitter

Pin 2 - Base

Pin 3 - Collector



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331